

第6节 静电场中的导体



实物按电特性分为：导体、半导体、绝缘体

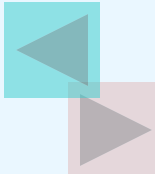
1. 导体：存在大量的可自由移动的电荷；

金属导体——自由电子

2. 绝缘体：理论上认为一个自由移动的电荷也没有，又称 电介质；

3. 半导体：介于上述两者之间。

本节讨论金属导体与电场的相互影响规律。



将金属导体放在静电场中：

- ①导体内的自由电荷，在电场力作用下作宏观定向移动，从而使导体中的电荷重新分布；
- ②电荷分布改变，电场分布随之改变。

一、导体静电平衡条件

1. 静电平衡

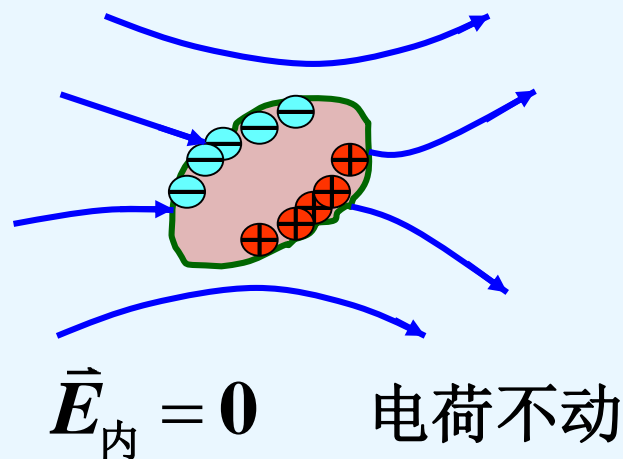
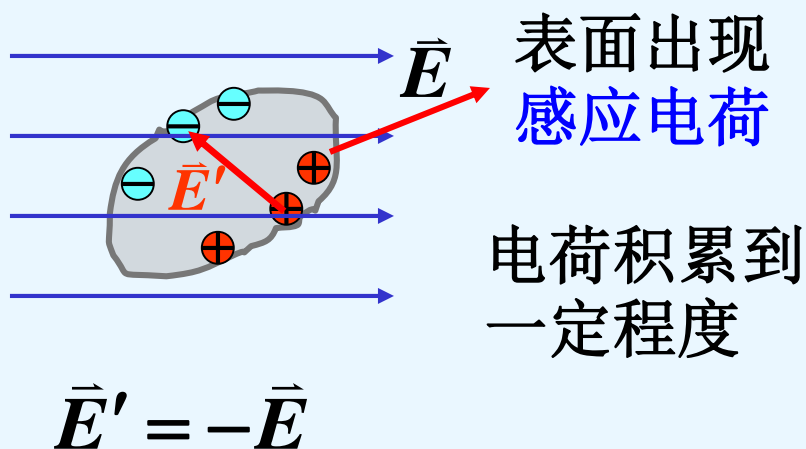
带电系统中，电荷静止不动，从而电场分布不随时间变化，则该系统达静电平衡状态。

2. 导体静电平衡条件

① 导体内部任何一点的场强等于 0。 $\vec{E}_{\text{内}} = 0$

② 导体表面任何一点的场强都垂直表面。 $\vec{E}_{\text{表面}} \perp \text{表面}$

例如：在均匀场放入一导体的情况



达静电平衡

3. 推论：导体的静电平衡条件的电势描述：

$$\vec{E} = -\nabla V$$

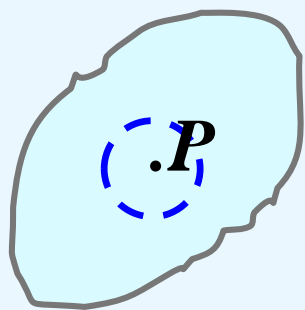
① 导体是等势体。

② 导体表面是等势面。 $V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$

二、导体上电荷分布

1. 体内无空腔 围任一点 P 作高斯面 S ，由高斯定理：

$$\oint_S \vec{E}_{\text{内}} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \therefore \sum q_{\text{内}} = 0$$



结论：导体内部无净电荷；
电荷只分布在导体表面。

2. 空腔导体

①空腔内有带电体：如有一正电荷 q

在导体壳内作一高斯面

$$\oint_s \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \sum q_{\text{内}} = 0$$

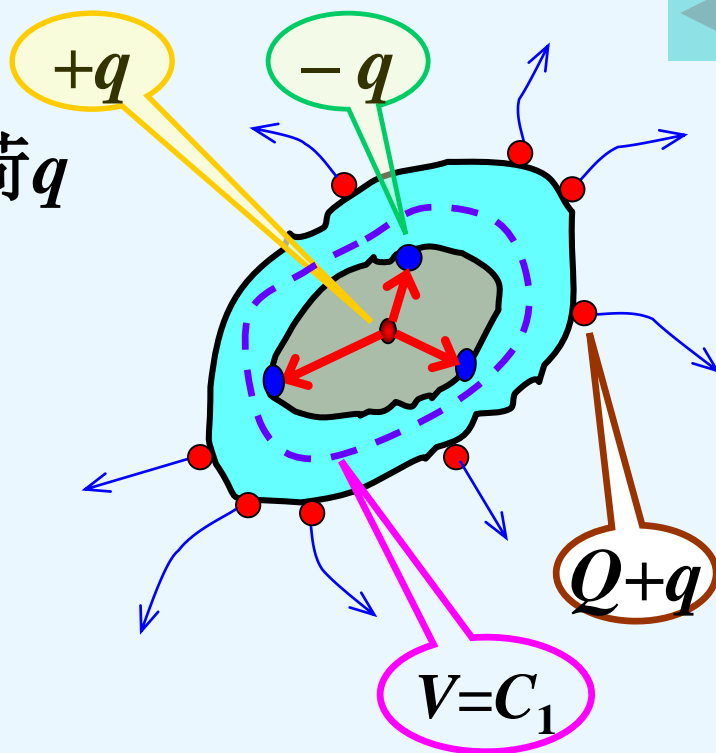
电荷：内表面有感应电荷 $-q$ 。

外表面感应电荷 $Q+q$ 。

电场： $(q, -q, q+Q) \Rightarrow \vec{E}_{\text{内}} = 0$

$(q, -q) \Rightarrow \vec{E}_{\text{外}} = 0$ ——空腔静电屏蔽

电势：空腔是等势体，腔内不等电势。



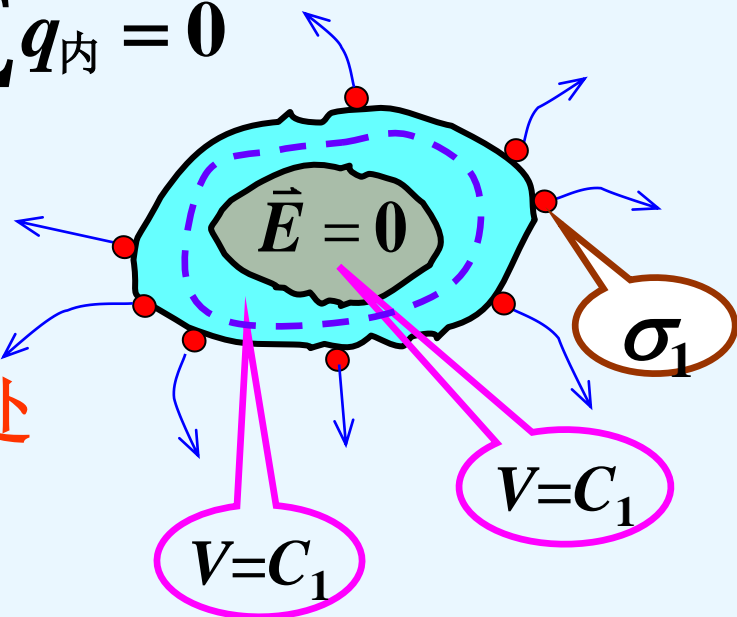
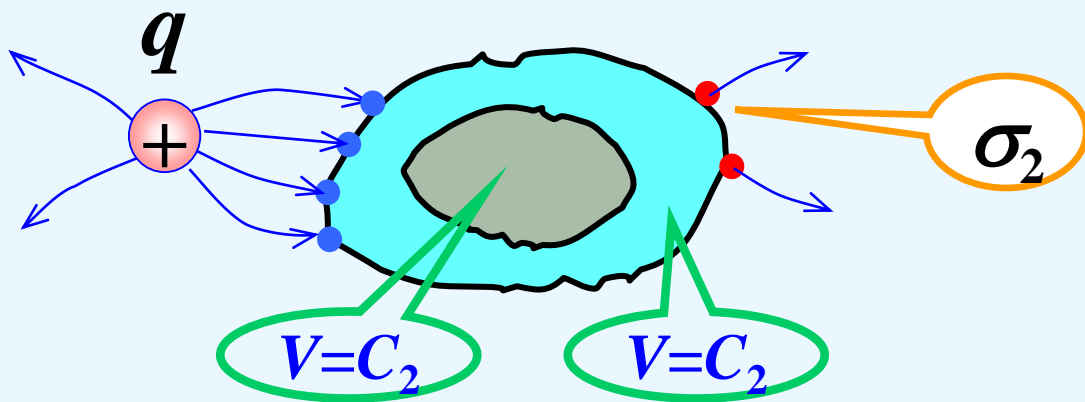
②空腔（带电）内无带电体

$$\sum q_{\text{内}} = 0$$

结论： 电荷分布在外表面，
内表面无电荷。

空腔内部及导体内部**电场强度处处为零**，即它们**等电势**。

这些结论不受腔外带电体的影响。

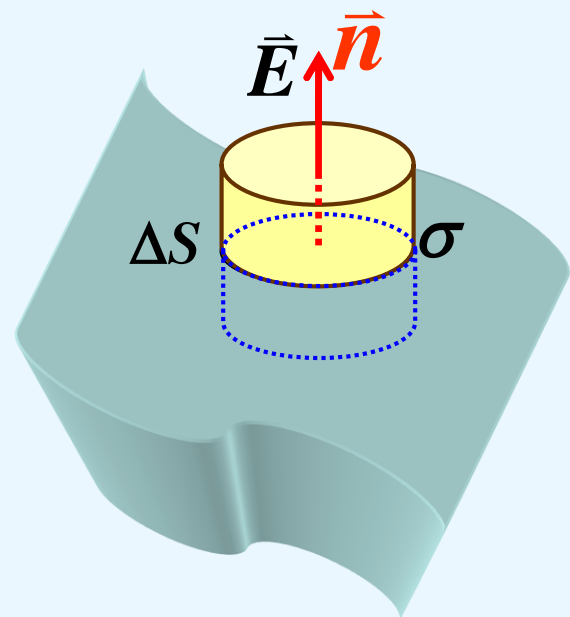


静电屏蔽的
另一种含义

腔外带电体与腔外表面电荷在腔内场强总贡献为零

三、导体表面上的场强与电荷面密度的关系

以 ΔS 为底面、轴线垂直 ΔS ，作高斯柱面：



$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{\text{上}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{下}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\text{侧}} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$= \int_{\text{上}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot \Delta S$$

$$\frac{1}{\epsilon_0} \sum q_i = \frac{\sigma \cdot \Delta S}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

方向 $\parallel \vec{n}$

导体表面上一点的场强 E 正比于该点的电荷面密度 σ

注：(1) $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ 仅表示 E 与 σ 的量值关系。但由 σ 可简便求出 E 的大小。

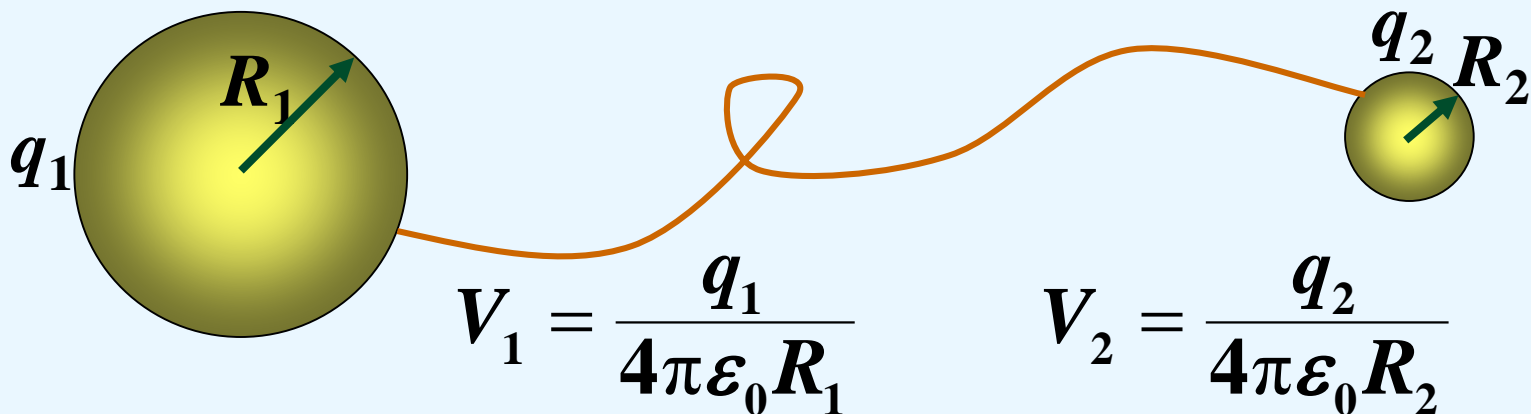
(2) 表面（空间）各点的电场，是所有电荷产生的。



四、电荷面密度与导体表面曲率的关系

一般导体电荷的分布与 $\left\{ \begin{array}{l} \text{导体形状有关} \\ \text{与附近其它带电体有关} \end{array} \right.$

孤立导体处于静电平衡时，电荷分布有定性规律：



两球用导线相连： $V_1 = V_2$ $\frac{q'_1}{R_1} = \frac{q'_2}{R_2}$ $q'_1 + q'_2 = q_1 + q_2$

$$\frac{\sigma_1 \cdot 4\pi R_1^2}{R_1} = \frac{\sigma_2 \cdot 4\pi R_2^2}{R_2} \quad \frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{R_2}{R_1} \quad \text{即：} \sigma \propto \frac{1}{R}$$

结论：

$$\sigma \propto \frac{1}{R}$$

孤立导体表面的电荷面密度
与该处的曲率半径成反比。

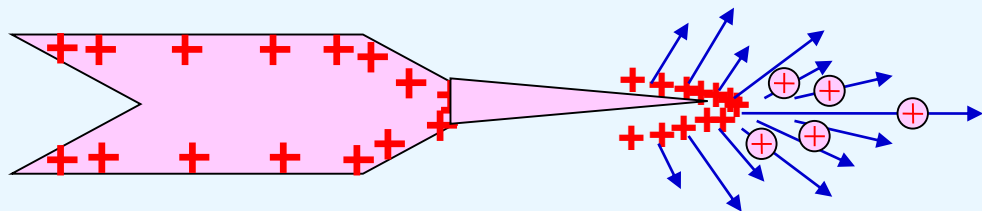
即：曲率越大的地方，电荷面密度越大。

平坦处： R 大 σ 小，则 E 小；

$$E \propto \sigma$$

尖端处： R 很小， σ 很大，则 E 很强；

凹面处： 曲率为负值， σ 更小，则 E 很弱。



尖端放电

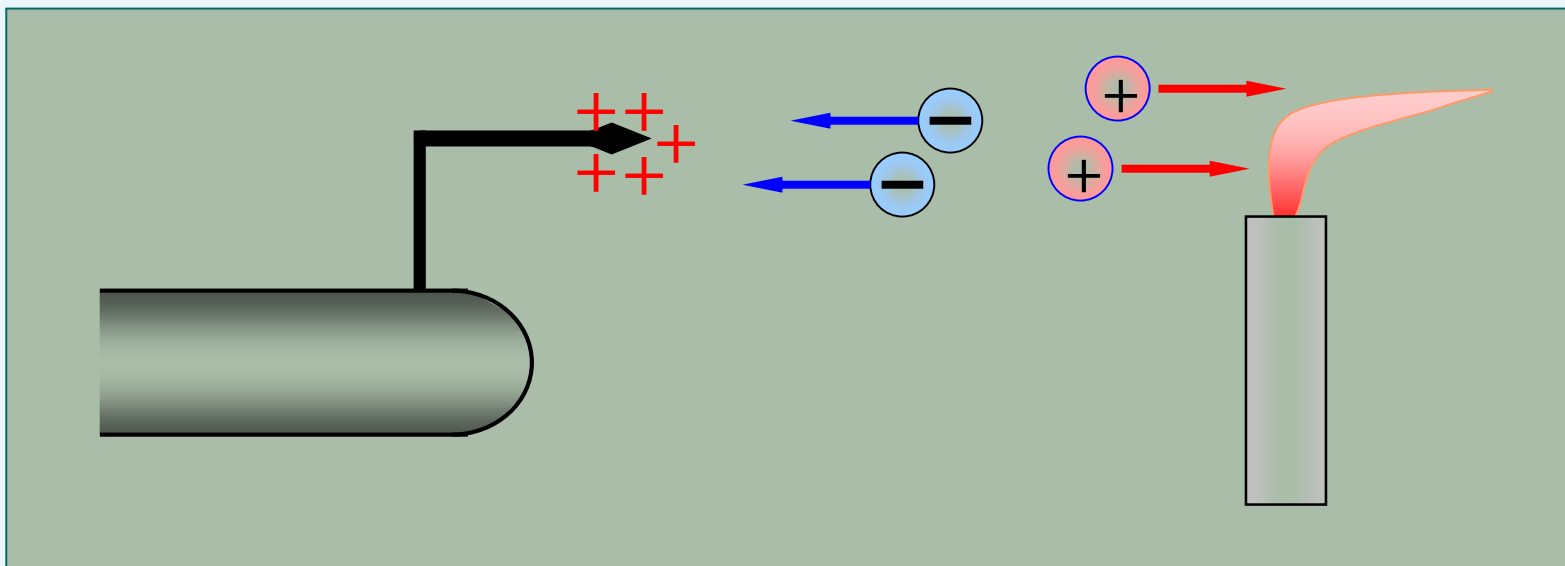
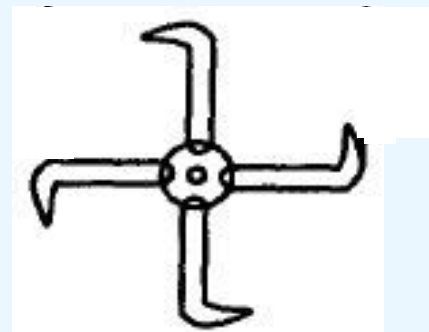
曲率很大的尖端：

$E \rightarrow$ 极强

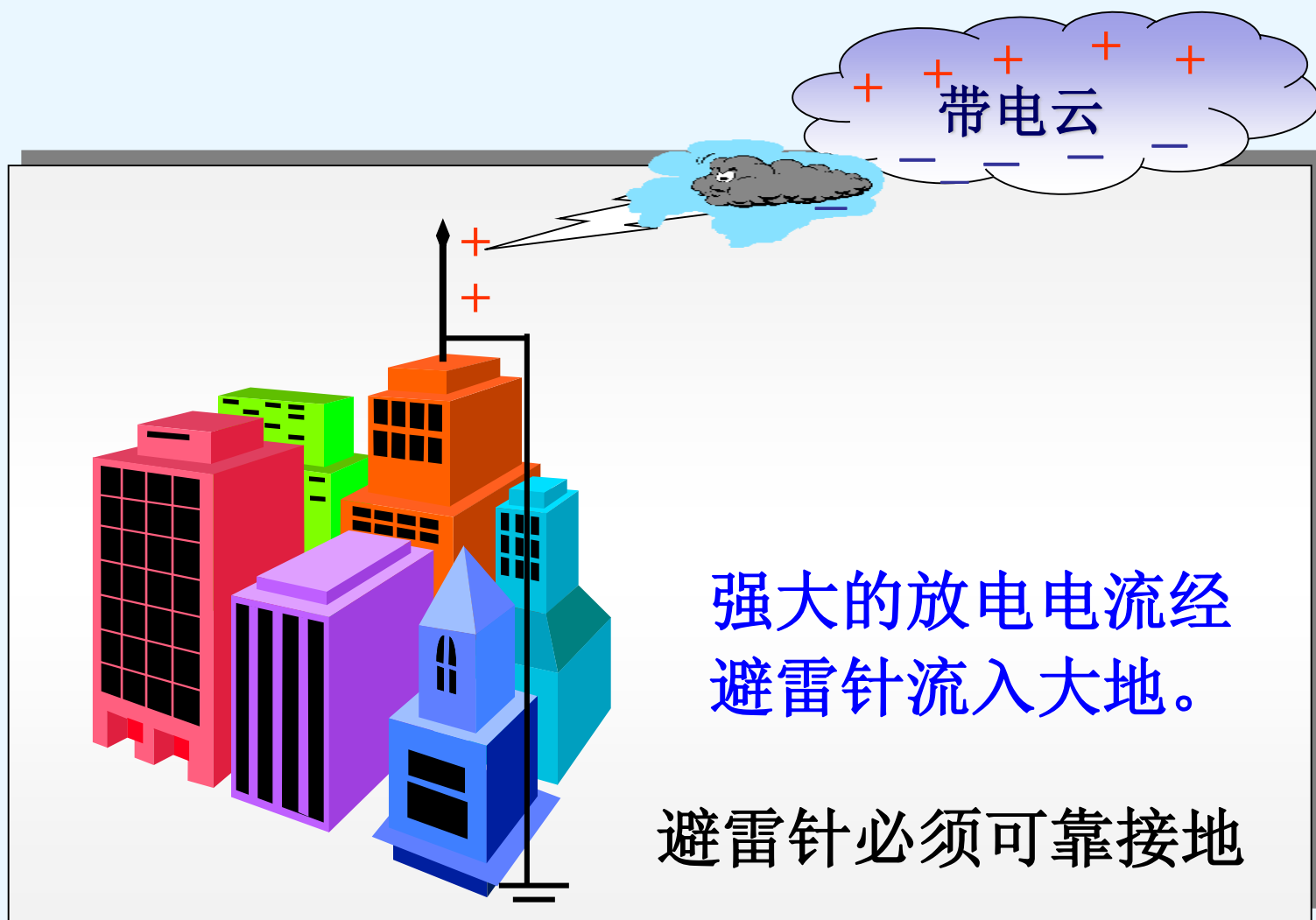
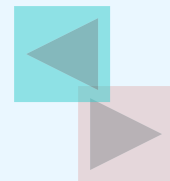
尖端放电

带电导体尖端附近的电场特别大，可使尖端附近的空气发生电离而成为导体产生放电现象。

电风实验



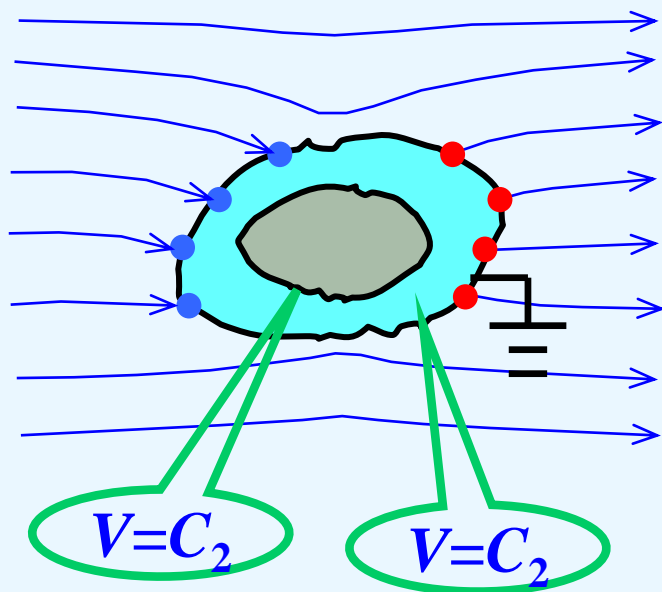
避雷针的工作原理



五、静电屏蔽

隔绝静电场和导体间的相互影响。

1. 空腔导体屏蔽外电场



使空腔内的物体不受外电场的影响。

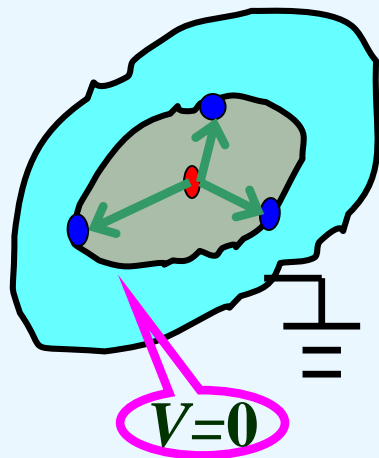
电势？

受外电场的影响

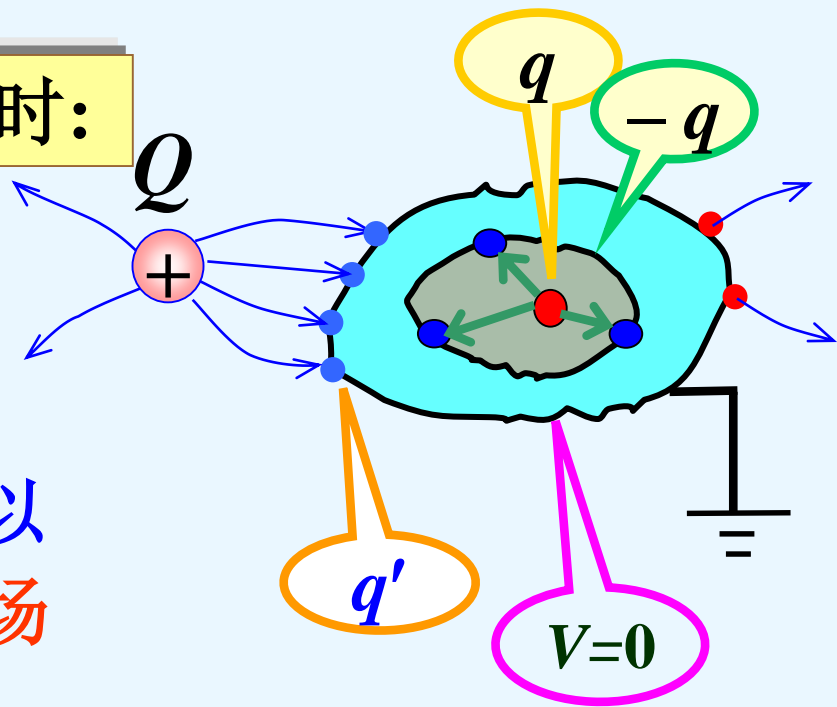
要维持空腔导体的电势不变，可把空腔导体**接地**。

2. 空腔导体消除空腔中的带电体对空腔外物体影响。

①空腔接地，腔外没有带电体时：
外表面上的感应电荷被大地电荷全部中和（即外表面不带电）。
金属空腔是零等势体。

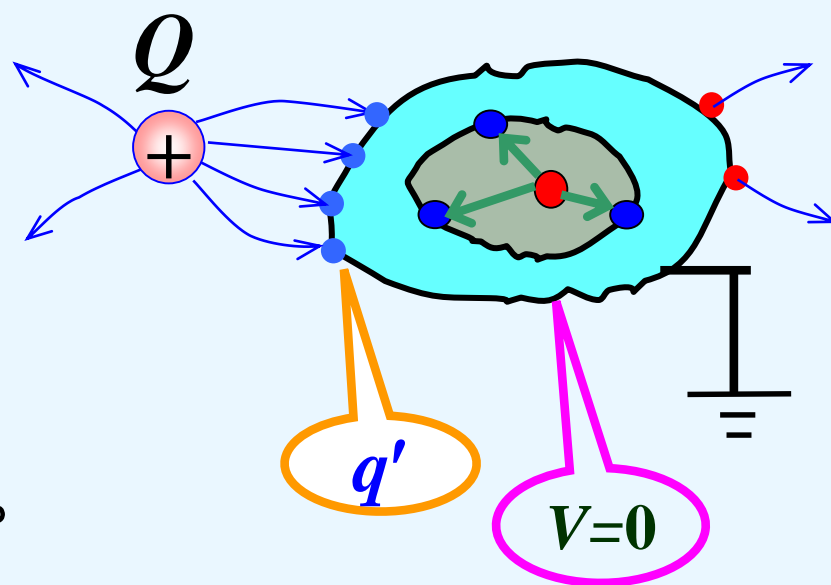


②空腔接地，腔外有带电体时：
外表面上的感应电荷被大地电荷部分中和，所带电量？
空腔满足静电平衡条件：
腔内、腔内表面、腔外表面以及腔外电荷在导体内产生的场强为零，金属空腔是零电势。



此时壳内的任何电场都不影响外界，也不受外界影响。

例如电子仪器设备都用金属导体壳接地做保护，它起静电屏蔽作用，内外互不影响。



一个接地的空腔导体可以隔离内外静电场的影响。

六、有导体存在时静电场的计算

电荷分布
电场分布

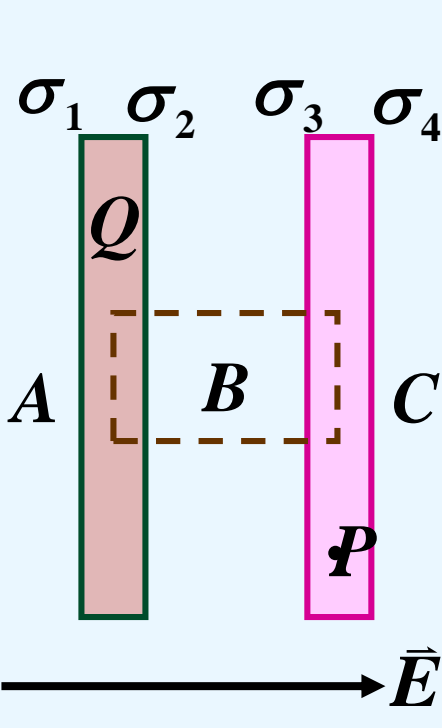
高斯定理、电势概念、电荷守恒定律、
导体静电平衡条件。

例1.一块金属平板，面积为 S 带电 Q ，在其旁放置第二块同面积的不带电金属板。求①达静电平衡时，电荷分布及空间电场分布。②若第二块板接地？（忽略边缘效应）

解：①达静电平衡，导体内部无净电荷，电荷只分布在表面上。

不考虑边缘效应，电荷是均匀分布。

设四个面上电荷面度分别为 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4$



则有：

$$\sigma_1 + \sigma_2 = Q/S$$

如图取高斯柱面可得：

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \sum q_i = 0$$

即：

$$\sigma_2 + \sigma_3 = 0$$

导体内任意一点 P ，其电场 $E=0$

则有：

$$\frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma_3}{2\epsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\epsilon_0} = 0$$

}

联立
求解

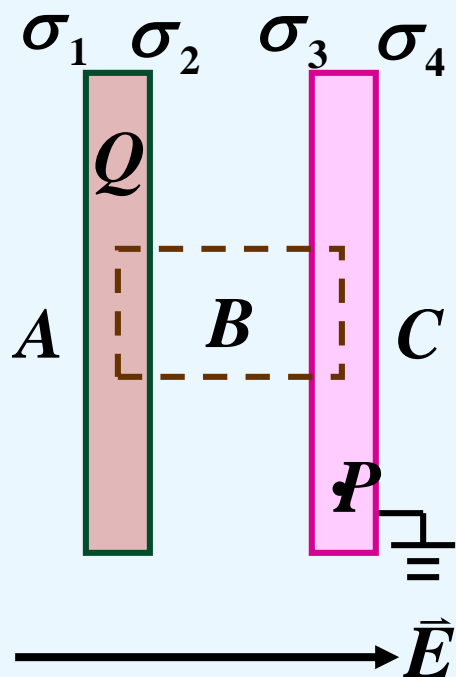
解得: $\sigma_1 = \sigma_2 = \frac{Q}{2S}$ $\sigma_3 = -\frac{Q}{2S}$ $\sigma_4 = \frac{Q}{2S}$

场强: $E_A = -\frac{Q}{2\epsilon_0 S}$, $E_B = \frac{Q}{2\epsilon_0 S}$, $E_C = \frac{Q}{2\epsilon_0 S}$

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

②第二板接地 则第二板与大地构成一导体 $\sigma_4 = 0$

同理可得: $\sigma_1 + \sigma_2 = \frac{Q}{S}$
 $\sigma_2 + \sigma_3 = 0$
 $\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 = 0$ } 联立求解:



$$\sigma_1 = 0 \quad \sigma_2 = \frac{Q}{S} \quad \sigma_3 = -\frac{Q}{S}$$

$$E_A = E_C = 0 \quad E_B = \frac{Q}{\epsilon_0 S}$$

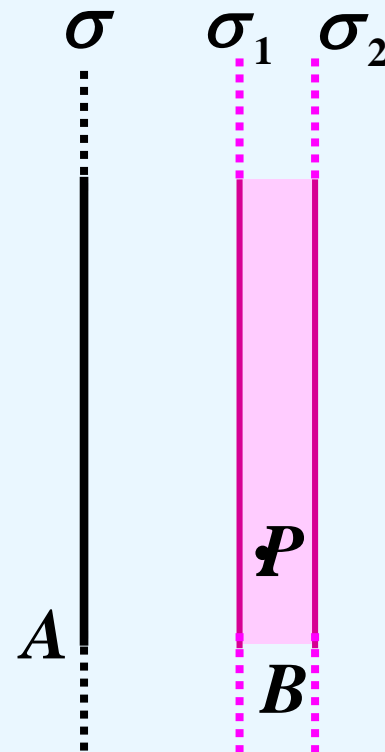
例. 无限大均匀带电平面A，其附近放置一块与它平行的有一定厚度的无限大平面导体板B。已知A上的电荷面密度为 $+\sigma$ ，则在导体板B的两个表面上的电荷面密度为：

(A) $\sigma_1 = -\sigma, \sigma_2 = +\sigma$

✓ (B) $\sigma_1 = -\frac{1}{2}\sigma, \sigma_2 = +\frac{1}{2}\sigma$

(C) $\sigma_1 = -\frac{1}{2}\sigma, \sigma_2 = -\frac{1}{2}\sigma$

(D) $\sigma_1 = -\sigma, \sigma_2 = 0$



$$\sigma_1 + \sigma_2 = 0$$

$$\sigma + \sigma_1 - \sigma_2 = 0$$

例2. 一个带电金属球A半径 R_1 ，带电量 q_0 ，放在另一个带电球壳B内，其内外半径分别为 R_2 、 R_3 ，球壳带电量为 q 。试求此系统的电荷、电场分布以及球与球壳间的电势差。

解： 设球壳内外表面电量： q_1 ， q_2

由高斯定理 $q_1 = -q_0$

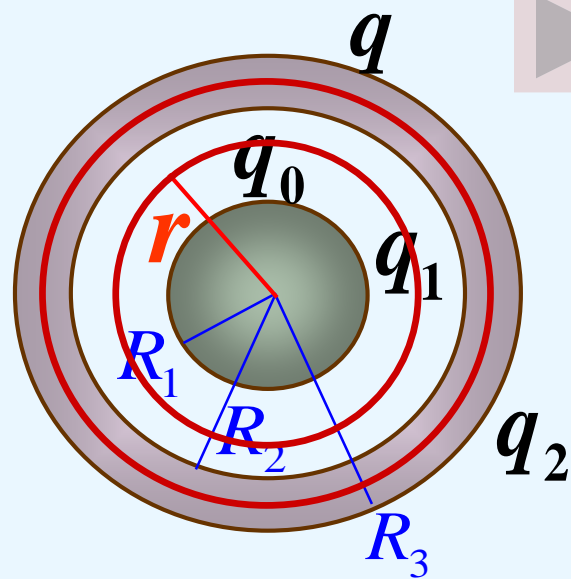
由电荷守恒 $q = q_1 + q_2$

$$q_2 = q + q_0$$

由电荷分布的对称性利用高斯定理得：

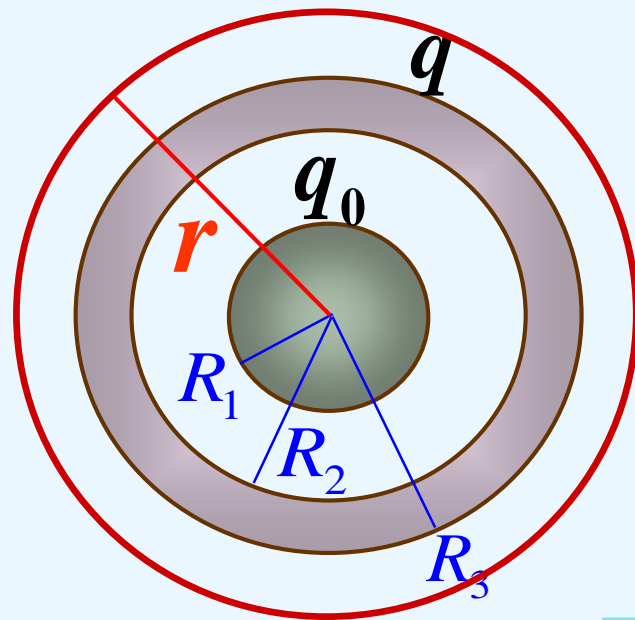
$$E = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$R_1 < r < R_2$$



$$E = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad R_1 < r < R_2$$

$$E = \frac{q_0 + q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad r > R_3$$



所以金属球A与金属壳B之间的电势差为：

$$V_{AB} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$



如果用导线将球壳和球接一下情形如何？

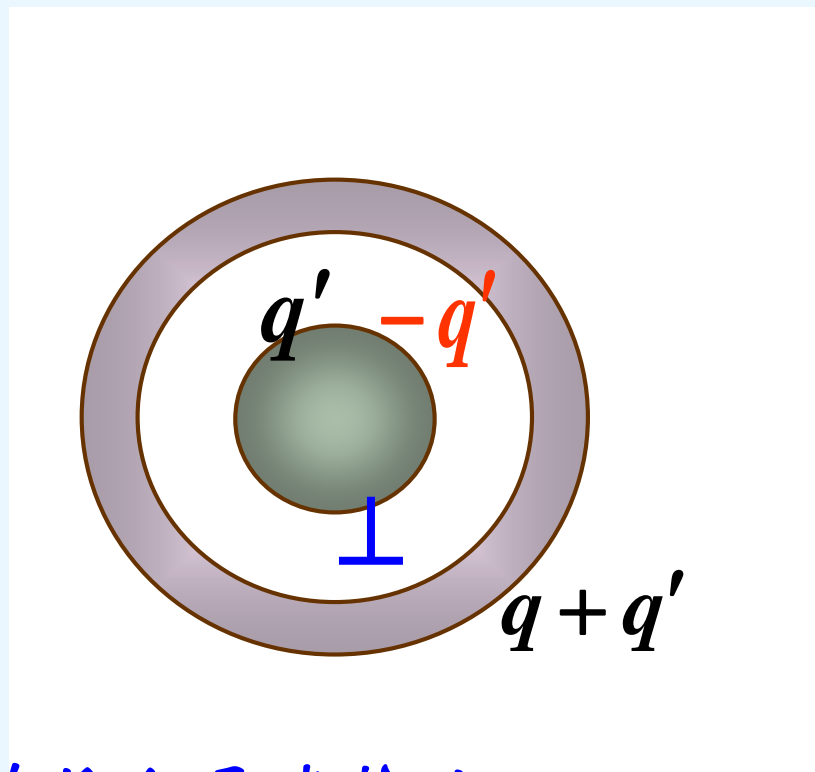
球壳B的内表面和球A表面的电荷完全中和，重新达到静电平衡，二者之间的电势差为零、场强为零。

$$q_0 = 0, \quad q_1 = 0$$

球壳外表面：

均匀分布 $q_2 = q + q_0$

$$E = \frac{q + q_0}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad r > R_3$$

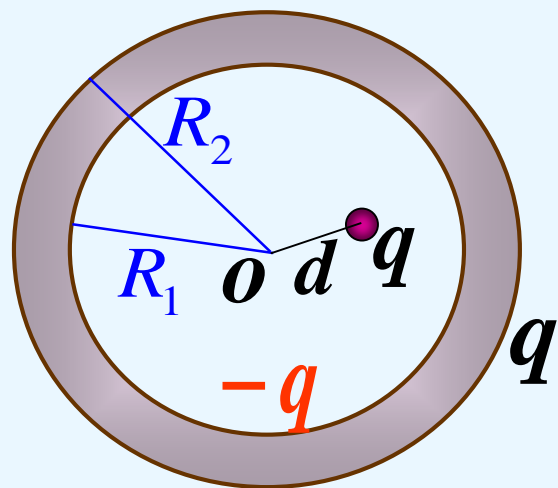


若将金属球接地？

此时金属球带电不为零！

但其电势为零！



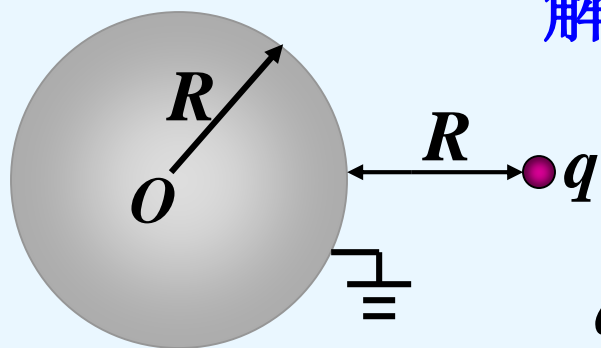


求球心 O 的电势

$$V_o = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

例3. 半径为 R 的金属球与地相连接，在与球心相距 $d=2R$ 处有一点电荷 $q(>0)$ ，问球上的感应电荷 $q'=?$

解： 金属球是等势体

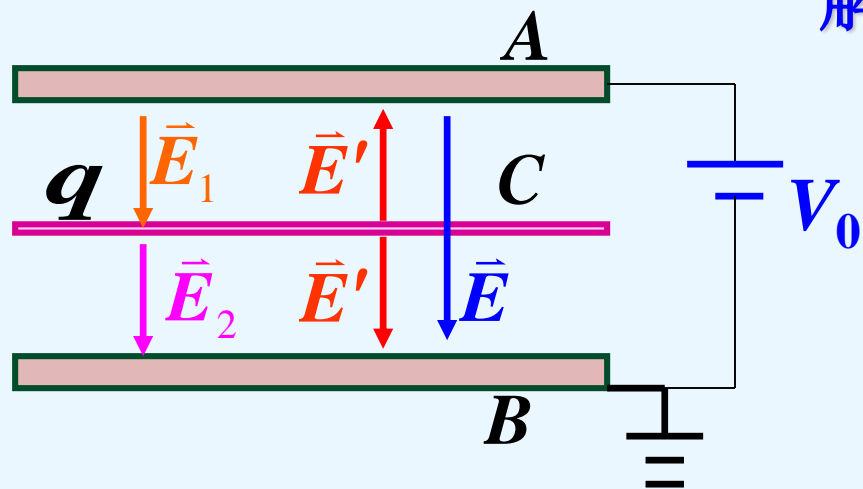


球体上处处电势 $V=0$ ，球心处 $V_o=0$

$$\frac{q'}{4\pi\epsilon_0 R} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 2R} = 0 \quad \therefore q' = -\frac{q}{2}$$

例4.两平行放置的无限大导体板A、B，面积均为 S ，间距为 d ，连接电源后，A板的电势 $V_A=V_0$ ，B板的电势 $V_B=0$ 。现将一带电量为 q ，面积也是 S 而厚度可忽略的导体片C平行地插在两导体板中间位置，求导体片C的电势。

解： 原板间电场为：



$$E = \frac{V_0}{d}$$

C板插入后，在两侧产生电场：

$$E' = \frac{q}{2\epsilon_0 S}$$

$$E_1 = E - E' = \frac{V_0}{d} - \frac{q}{2\epsilon_0 S}$$

$$E_2 = E + E' = \frac{V_0}{d} + \frac{q}{2\epsilon_0 S}$$

$$V_C = E_2 \frac{d}{2} = \frac{V_0}{2} + \frac{qd}{4\epsilon_0 S}$$